



## 主要用途:

电子镇流器、节能灯、充电器、LED电源及各类功率开关电路。

## 主要特点:

耐压高、开关速度快、安全工作区大、输出特性好、电流容量大，带阻尼二极管。

封装形式: TO-252 管脚: BCE

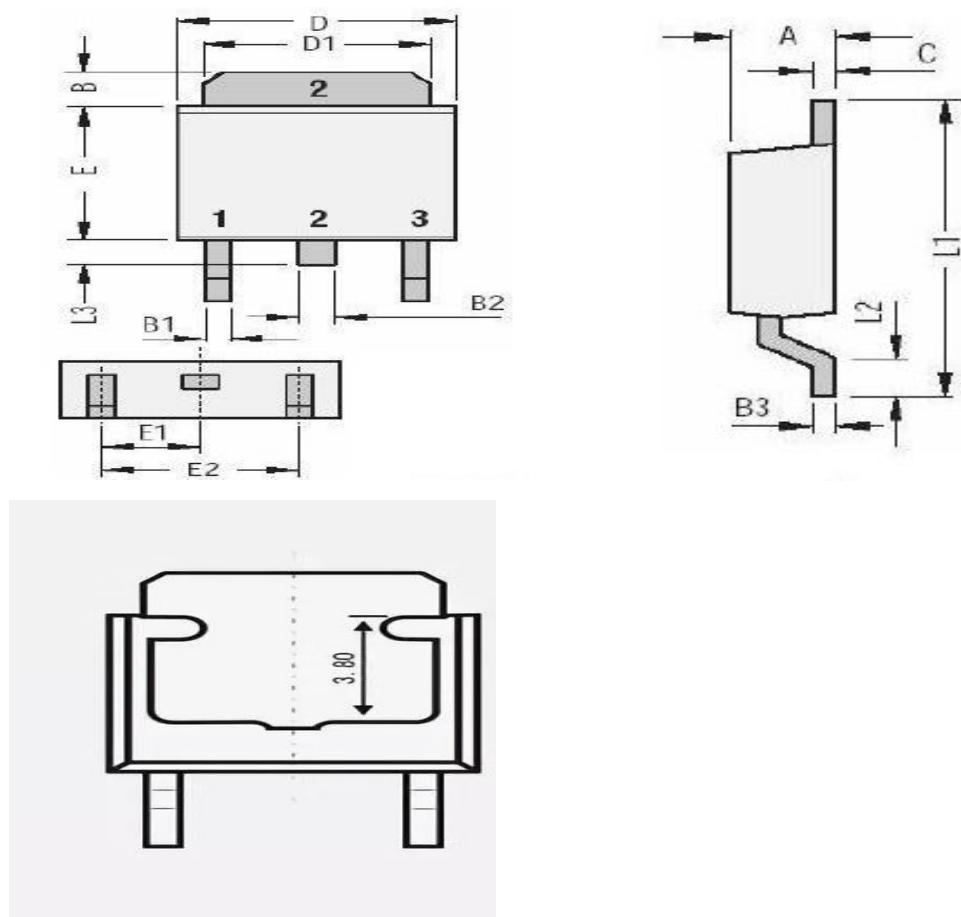
极限值 ( $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-发射极击穿电压	BVceo	$\geq 480$	V
集电极-基极击穿电压	BVcbo	$\geq 700$	V
发射极-基极击穿电压	BVebo	$\geq 9$	V
最大集电极直流电流	Icm	1.0	A
耗散功率 ( $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ )	Ptot	1.25	W
最高工作温度	Tj	150	$^{\circ}\text{C}$
贮存温度	Tstg	-55~150	$^{\circ}\text{C}$

电特性 ( $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ )

参数名称	符号	测试条件	额定值		单位
			最小值	最大值	
集电极-发射极击穿电压	BVceo	$I_c=1\text{mA}$ $I_B=0$	480		V
集电极-基极击穿电压	BVcbo	$I_c=1\text{mA}$ $I_E=0$	700		V
发射极-基极击穿电压	BVebo	$I_E=1\text{mA}$ $I_c=0$	9		V
集电极-发射极反向漏电流	Iceo	$V_{ce}=410\text{V}$ $I_B=0$		5	$\mu\text{A}$
集电极-发射极反向漏电流	Icbo	$V_{cb}=680\text{V}$ $I_E=0$		5	$\mu\text{A}$
发射极-基极反向漏电流	Iebo	$V_{eb}=7\text{V}$ $I_c=0$		5	$\mu\text{A}$
共发射极直流电流增益	Hfe	$V_{ce}=5\text{V}$ $I_c=0.2\text{A}$	15	35	
		$V_{ce}=5\text{V}$ $I_c=1\text{mA}$	15		
集电极-发射极饱和压降	Vcesat	$I_c=0.5\text{A}$ $I_B=0.2\text{A}$		0.5	
存储时间	Ts	$I_c=250\text{mA}$	1.5	3.5	$\mu\text{s}$
特征频率	f <sub>r</sub>	$V_{ce}=10\text{V}$ $I_c=0.1\text{A}$ $f=1\text{MHz}$	5		MHZ
续流二极管正向压降	VFEC	IC:0.5A		1.8	V

## 封装尺寸



All Dimensions are in mm

DIM	MIN	MAX
A	2.2	2.4
B	1.4	1.7
B1	0.58	0.7
B2	0.75	0.85
B3	0.46	0.58
C	0.48	0.52
D	6.3	6.6
D1	5.25	5.5
E	5.35	5.5
E1	2.25	2.35
E2	4.5	4.7
L1	9.5	10
L2	1.2	1.6
L3	0.6	0.8